


请输入关键词 

- 网站首页
- 实验室概况
- 新闻中心
- 科研团队
- 科学研究
- 开放交流
- 人才培养
- 仪器设备
- 学术简报
- English

您现在所在位置：首页 > 科学研究 / 授权专利

授权专利 

部分国家发明专利（1）

作者： 文章来源： 发布时间：2011-12-21 阅读次数：1497

◇ 自对准槽栅CMOS集成电路制造方法	00114825.7
◇ 一种16位微处理器的系统结构	03114501.9
◇ 双算术逻辑单元精简指令集8位微控制器	200510041649.9
◇ 碳化硅金属半导体场效应晶体管	03105805.1
◇ III-V族化合物材料上原位淀积SiO ₂ 金属膜的方法	200510042671.5
◇ 金属有机物化学气相淀积设备的恒流配气系统及控制方法	200510042809.1
◇ GaN半导体材料的异质外延方法	200510043168.1
◇ 垂直型宽禁带半导体器件结构	200510043057.0
◇ 磷化镓材料上原位淀积高介电常数Al ₂ O ₃ 和金属膜的方法	2005100962334.1
◇ GaN基化合物材料上原位淀积高介电常数Al ₂ O ₃ 和金属膜的方法	200510096233.7
◇ 一种单次生长制备复合多量子阱结构的方法	200610041962.7
◇ GaN单晶缺陷种类和密度的检测方法	200610042911.6
◇ 一种大面积自支撑宽禁带半导体材料的制作方法	200610105112.9
◇ 基于自支撑的SiC的GaN器件及制作方法	200610105132.6
◇ 化合物半导体微波大功率器件中的空气桥制作方法	200710018147.3
◇ 基于Al ₂ O ₃ 封底的GaN薄膜的生长方法	200710018353.4
◇ 基于组份渐变GaN MISFET的GaN器件及制备方法	200710018772.8
◇ InAlN/GaN异质结增强型高电子迁移率晶体管结构及制作方法	200810017777.3
◇ 适用于氮化镓器件N型欧姆接触制作方法	200810150273.9

 打印本页  关闭窗口

© 2013- 2021 西安电子科技大学宽带隙半导体国家重点实验室 版权所有

地 址: 陕西省西安市雁塔区太白南路2号

电 话: 029-88201759-855

E_mail: jiabol@xidian.edu.cn

邮 编: 710071

Design & Support 技术支持: 新势力网络



/ 西安电子科技大学微电子学院 / 西安电子科技大学科学研究院
 / 宽禁带半导体国家工程研究中心
 / 宽禁带半导体材料教育部重点实验室 / 中科院上海微系统与信息所
 / 中科院半导体所 / 清华大学信息科学技术学院
 / 中科院微电子所 / 北京大学软件与微电子学院

/ 西安电子科技大学